

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年12月1日(01.12.2022)



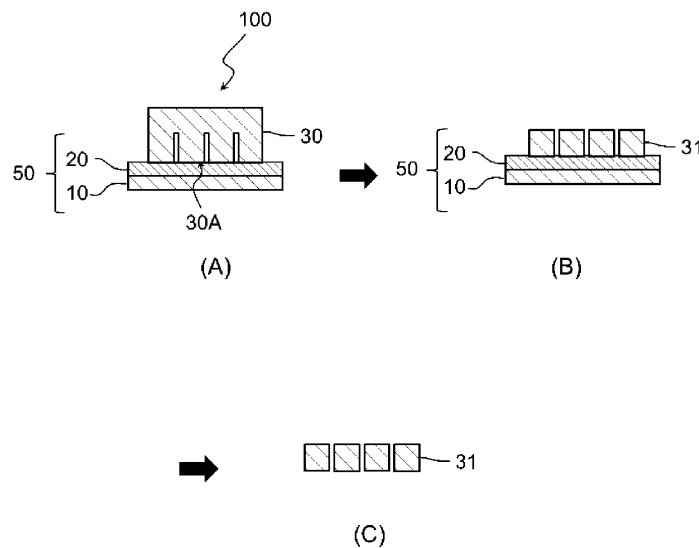
(10) 国際公開番号

WO 2022/250136 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 133/00 (2006.01) C09J 7/38 (2018.01)
H01L 21/301 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/021702
- (22) 国際出願日: 2022年5月27日(27.05.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-090312 2021年5月28日(28.05.2021) JP
- (71) 出願人: 三井化学東セロ株式会社
(MITSUI CHEMICALS TOHCCELLO, INC.) [JP/
JP]; 〒1018485 東京都千代田区神田美
土代町 7 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 安井 浩登(YASUI Hiroto); 〒2990265 千
葉県袖ヶ浦市長浦 5 8 0 - 3 2 三井化学株
式会社内 Chiba (JP). 栗原 宏嘉(KURIHARA
Hiroyoshi); 〒4570801 愛知県名古屋市南区丹
後通 2 - 1 三井化学東セロ株式会社内 Aichi
(JP). 木下 仁(KINOSHITA Jin); 〒4570801 愛
知県名古屋市南区丹後通 2 - 1 三井化学
東セロ株式会社内 Aichi (JP).
- (74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI Shinji); 〒1410031
東京都品川区西五反田 7 丁目 9 番 2 号 K
D X 五反田ビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: 電子装置の製造方法



(57) Abstract: This method for producing an electronic device at least includes: a step (A) for preparing a structure comprising a wafer which has a circuit-forming surface and an adhesive film stuck on the circuit-forming surface side of the wafer; a step (B) for backgrinding the surface on the side opposite to the circuit-forming surface side of the wafer; and a step (C) for irradiating the adhesive film with UV light and thereafter removing the adhesive film from the wafer. The adhesive film comprises: a base layer; and an adhesive resin layer which is

[続葉有]

CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,
KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE,
PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

provided on one side of the base layer and which is composed of a UV-curable adhesive resin material. In step (C), $E'(100^\circ\text{C})$, which is the storage elastic modulus at 100°C of the adhesive resin layer of the adhesive film after being irradiated with UV light, is 1.0×10^6 to 3.5×10^7 Pa when measured under the condition shown below, and $E'(100^\circ\text{C})/E'(-15^\circ\text{C})$ is 2.0×10^{-3} to 1.5×10^{-2} . (Condition) The dynamic viscoelasticity is measured in tensile mode at a frequency of 1 Hz and in the temperature range from -50°C to 200°C .

(57) 要約: 回路形成面を有するウエハと、ウエハの回路形成面側に貼り合わされた粘着性フィルムと、を備える構造体を準備する工程 (A) と、ウエハの回路形成面側とは反対側の面をバックグランドする工程 (B) と、粘着性フィルムに紫外線を照射し、その後、ウエハから粘着性フィルムを除去する工程 (C) と、を少なくとも備える電子装置の製造方法。粘着性フィルムは、基材層と、基材層の一方の面側に設けられた、紫外線硬化性粘着性樹脂材料により構成された粘着性樹脂層と、を備える。工程 (C) において、紫外線を照射した後の粘着性フィルムの粘着性樹脂層の、下記の条件で測定される、 100°C における貯蔵弾性率を $E'(100^\circ\text{C})$ は $1.0 \times 10^6 \sim 3.5 \times 10^7$ Pa であり、 $E'(100^\circ\text{C})/E'(-15^\circ\text{C})$ は $2.0 \times 10^{-3} \sim 1.5 \times 10^{-2}$ である。(条件) 周波数 1 Hz、引張モードで、温度 $-50 \sim 200^\circ\text{C}$ の範囲で動的粘弾性を測定する。